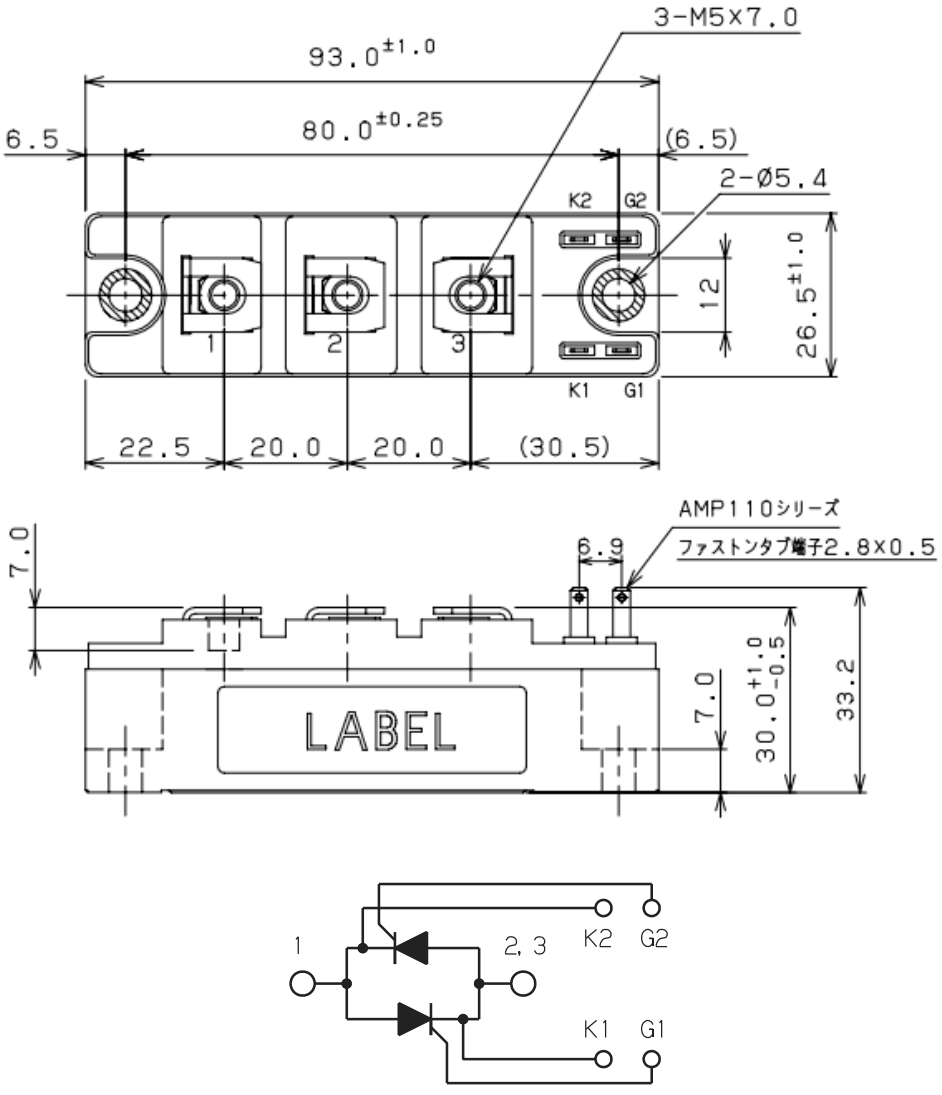
Thyristor Module

K02TA100P080AAA

特徴
Feature
- **RoHS 指令準拠**
  RoHS Compliant

用途
Application
- 一般整流用
  For General Use

外形図
Outline Drawing



【単位：mm】

回路構成 Circuit Schema

最大定格　Maximum Ratings

項　目 Parameter	記 号 Symbol	耐圧クラス　Grade		単位 Unit
		K02TA100P080AAA		
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DRM}	800		V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DSM}	900		V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	800		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	900		V

項　目 Parameter		記 号 Symbol	条　件 Conditions		定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 Average Rectified Output Current		$I_{T(AV)}$	商用周波数 180°　通電　　Tc=82℃ Half Sine Wave		100	A
実効オン電流 RMS On-State Current		$I_{T(RMS)}$			156	A
サージオン電流 Surge On-State Current		I_{TSM}	50Hz 正弦半波，1 ｻｲｸﾙ，非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		2000	A
電流二乗時間積 I Squared t		I^2t	2～10ms		20000	A^2 s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current		di/dt	V_D= 2/3V_{DRM} I_{TM}= 2I_T, Tj= 125℃ I_G= 200mA, di_G/dt= 0.2A/μs		100	A/μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power		P_{GM}			5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power		$P_{G(AV)}$			1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current		I_{GM}			2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage		V_{GM}			10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage		V_{RGM}			5	V
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		Tjw			-40 ～ +125	℃
保存温度範囲 Storage Temperature Range		Tstg			-40 ～ +125	℃
絶縁耐圧 Isolation Voltage		Viso	端子ーベース間，AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1min.		2500	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Base	F	ｻｰﾏﾙｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ塗布 Greased	M5	2.4 ～ 2.8	N・m
	主端子部 Terminal			M5	2.4 ～ 2.8	N・m

1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

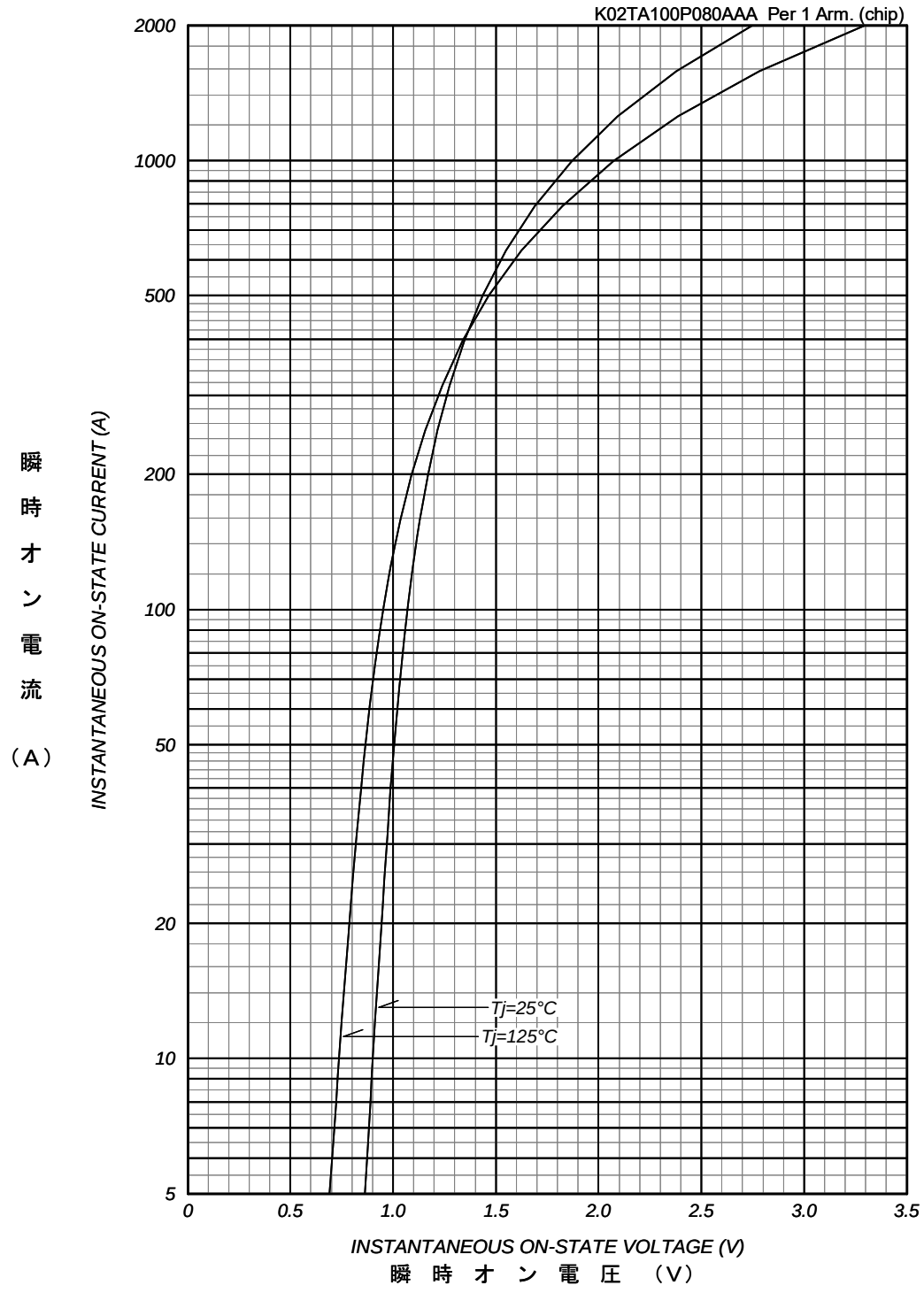
電気的特性　Electrical Characteristics

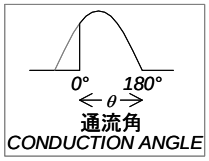
項　目 Parameter	記 号 Symbol	条　件 Conditions		特性値 Values			単位 Unit
				最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I_{DM}	Tj= 125℃, V_{DM}= V_{DRM}				20	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	Tj= 125℃, V_{RM}= V_{RRM}				20	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V_{TM}	Tj= 25℃ I_{TM}= 300A	Terminal			1.45	V
			Chip			1.26	
	$V_{(T0)}$ *1	Tj=125℃				0.82	V
	r_t *1	Tj=125℃				1.34	mΩ
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I_{GT}	V_D= 6V, I_T= 1A	Tj= -40℃			200	mA
			Tj= 25℃			100	mA
			Tj= 125℃			50	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	V_D= 6V, I_T= 1A	Tj= -40℃			4	V
			Tj= 25℃			2.5	V
			Tj= 125℃			2	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V_{GD}	Tj= 125℃, V_D= 2/3V_{DRM}		0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	Tj= 125℃, V_D= 2/3V_{DRM}, R_{GK}= 33Ω		500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t_q	Tj= 125℃, I_{TM}= I_T, V_D= 2/3V_{DRM} dv/dt= 20V/μs, V_R= 100V, -di/dt= 20A/μs			100		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t_{gt}	Tj= 25℃, V_D= 2/3V_{DRM} I_G= 200mA, di_G/dt= 0.2A/μs			6		μs
遅れ時間 Delay Time	t_d				2		μs
立上がり時間 Rise Time	t_r				4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I_L	Tj= 25℃			100		mA
保持電流 Holding Current	I_H	Tj= 25℃			50		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ｹｰｽ間(Tc 測定点：ﾁｯﾌﾟ直下) Junction to Case				0.3	℃/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ｹｰｽ-ﾌｨﾝ間，ｻｰﾏﾙｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ塗布 Case to Fin, Greased				0.2	℃/W

質　量 －－－ 約 120g　　Approximate Weight　　1 アーム当りの値　Value Per 1 Arm.

*1：$V_T \fallingdotseq V_{(TO)} + I_T \times r_t$　For power-loss calculation only

オ ン 電 圧 特 性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE

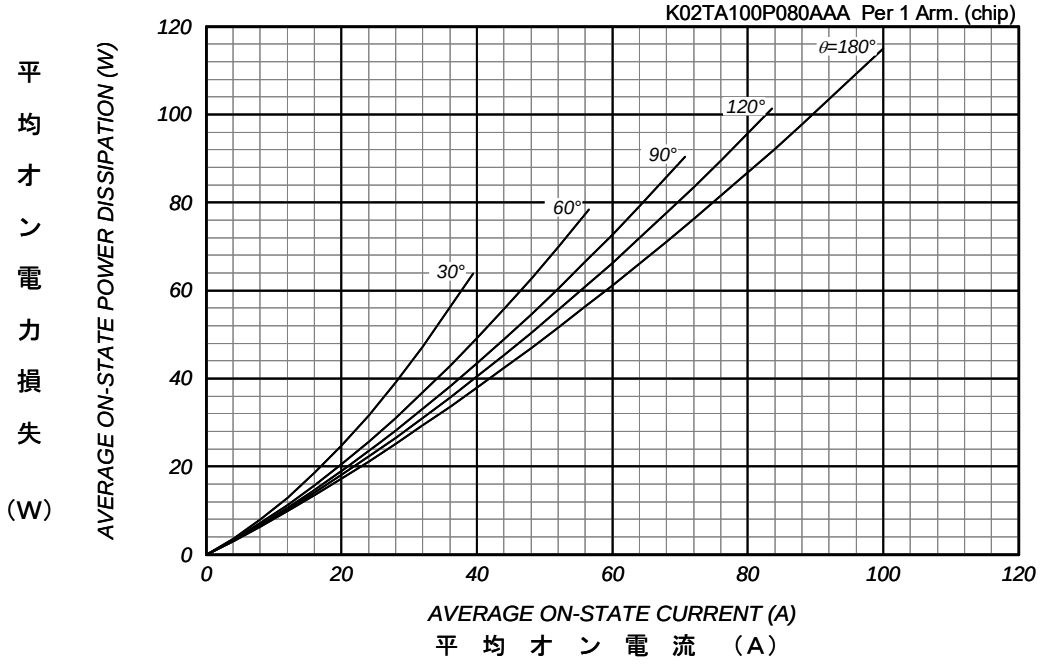


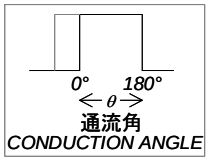


平 均 オ ン 電 力 損 失 特 性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

for SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM

K02TA100P080AAA Per 1 Arm. (chip)

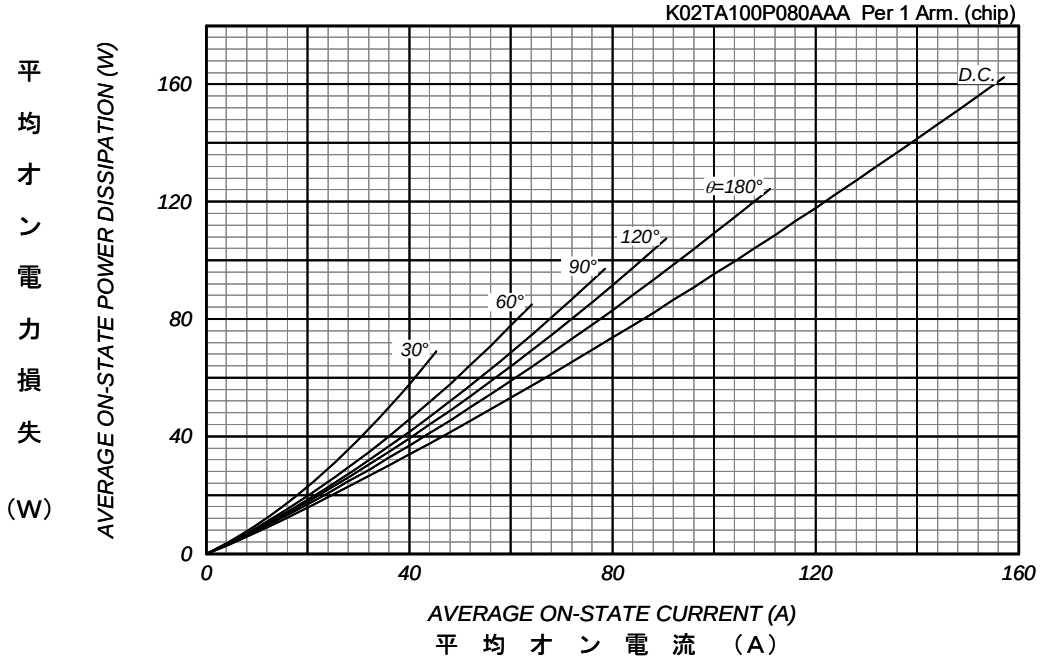


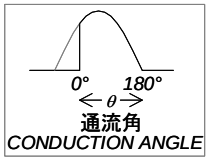


平 均 オ ン 電 力 損 失 特 性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

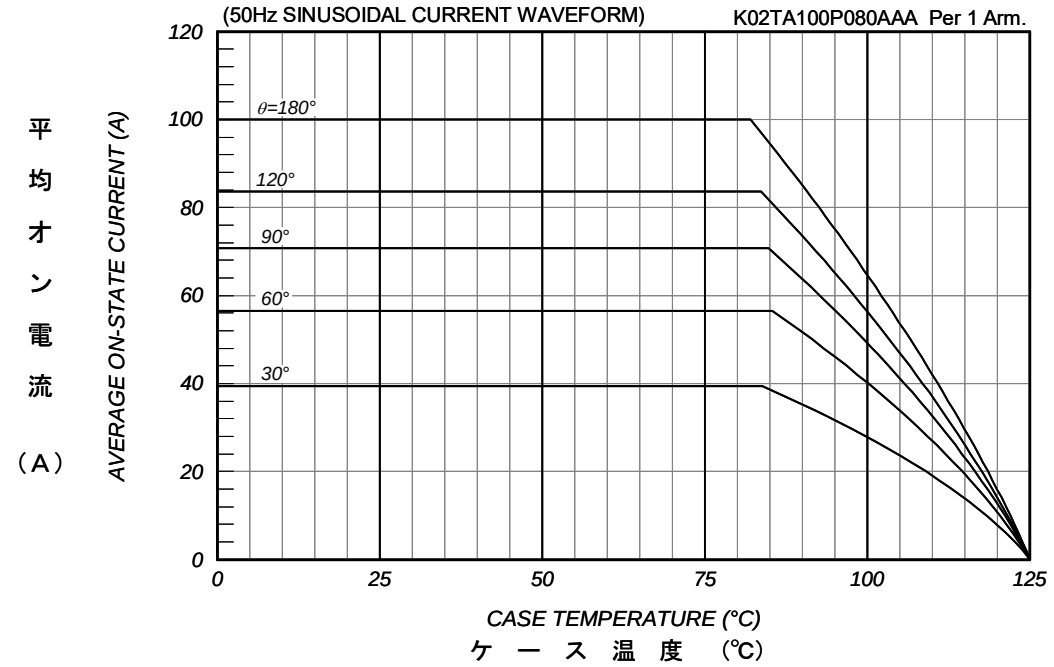
for RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM

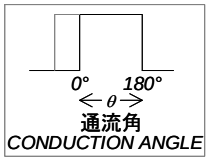
K02TA100P080AAA Per 1 Arm. (chip)



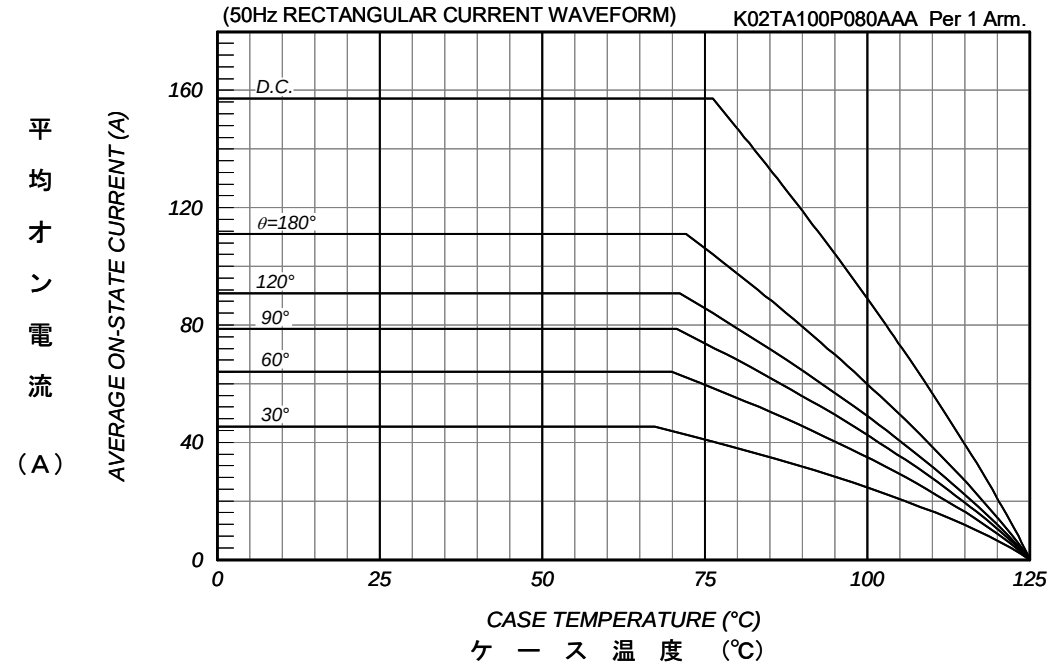


平 均 オ ン 電 流 － ケ ー ス 温 度 定 格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



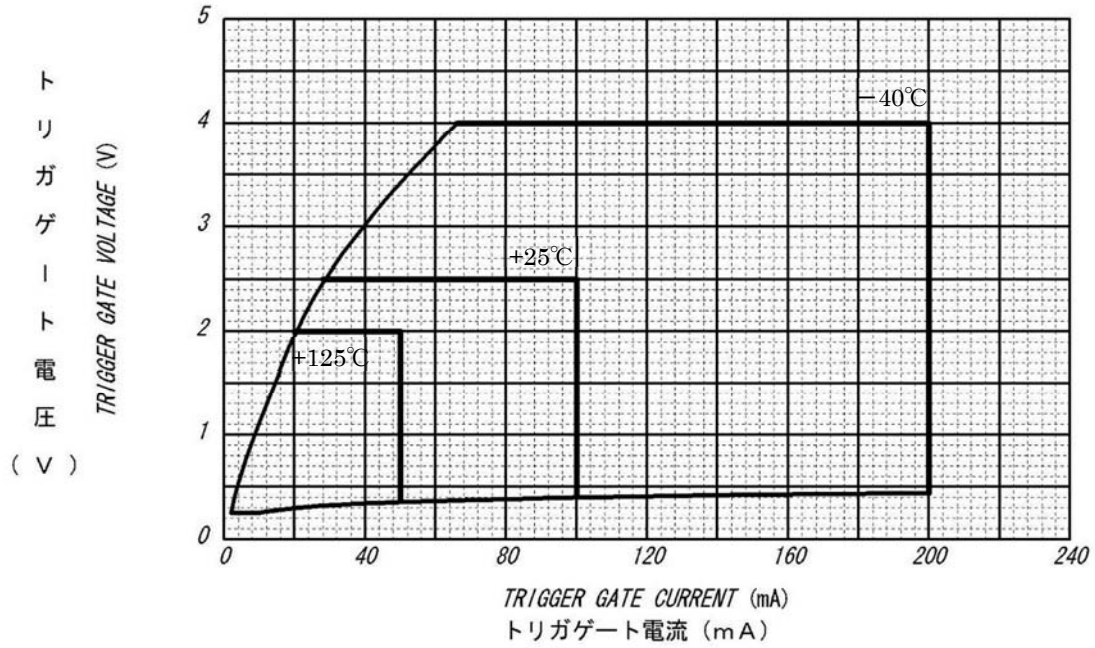


平 均 オ ン 電 流 － ケ ー ス 温 度 定 格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



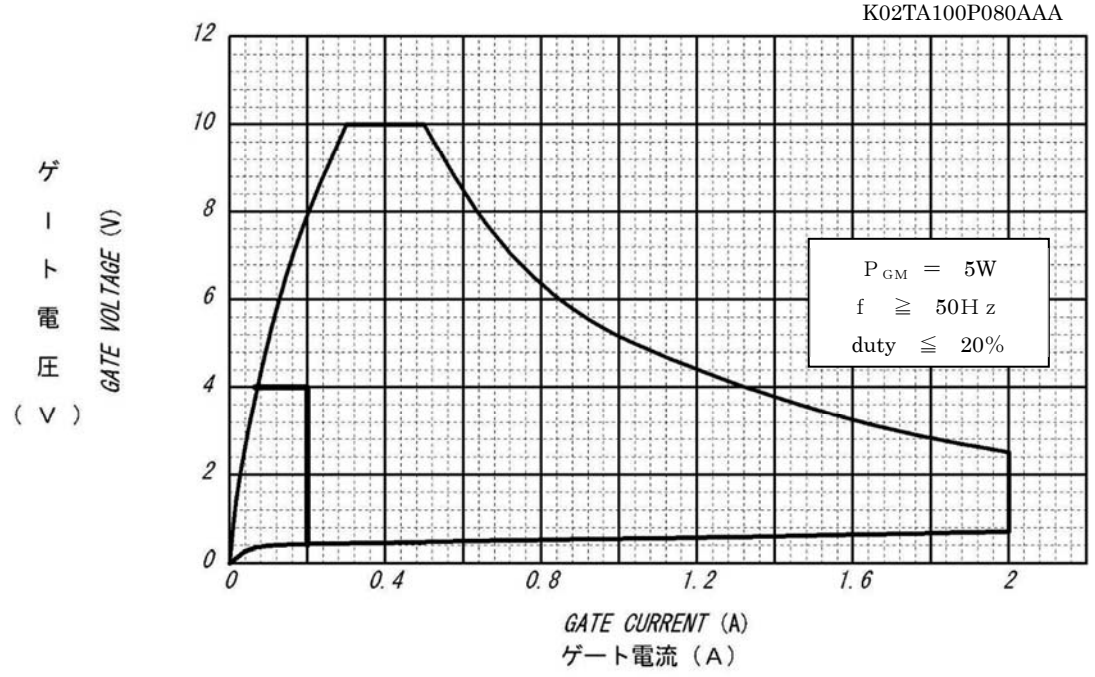
ゲ ー ト 特 性
GATE CHARACTERISTCS

K02TA100P080AAA

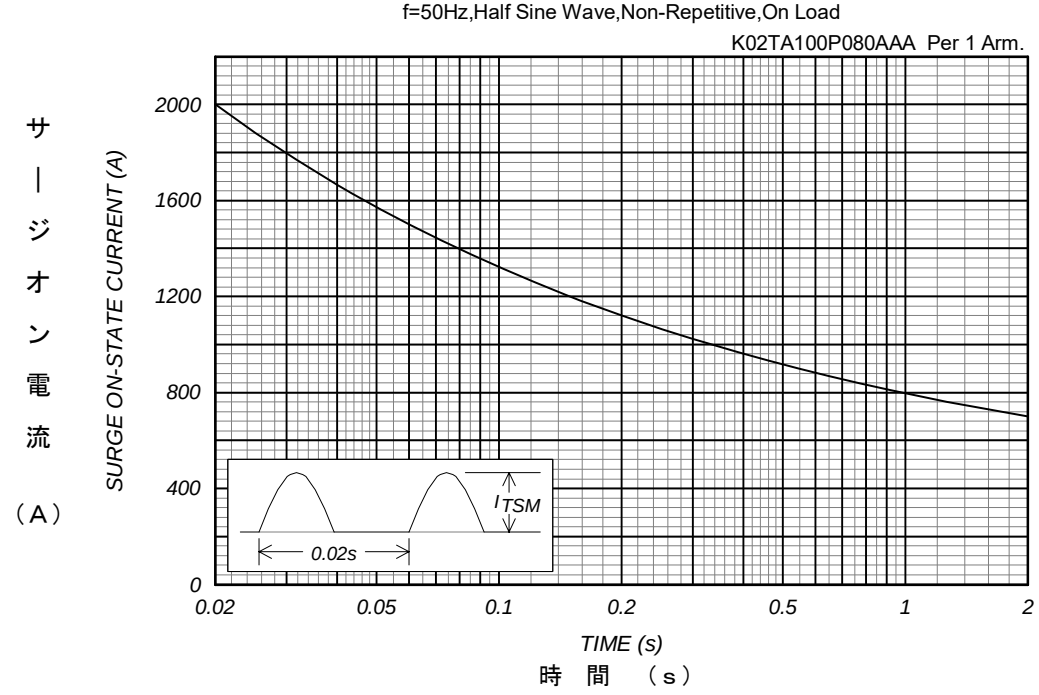


ゲ ー ト 定 格
GATE RATINGS

K02TA100P080AAA

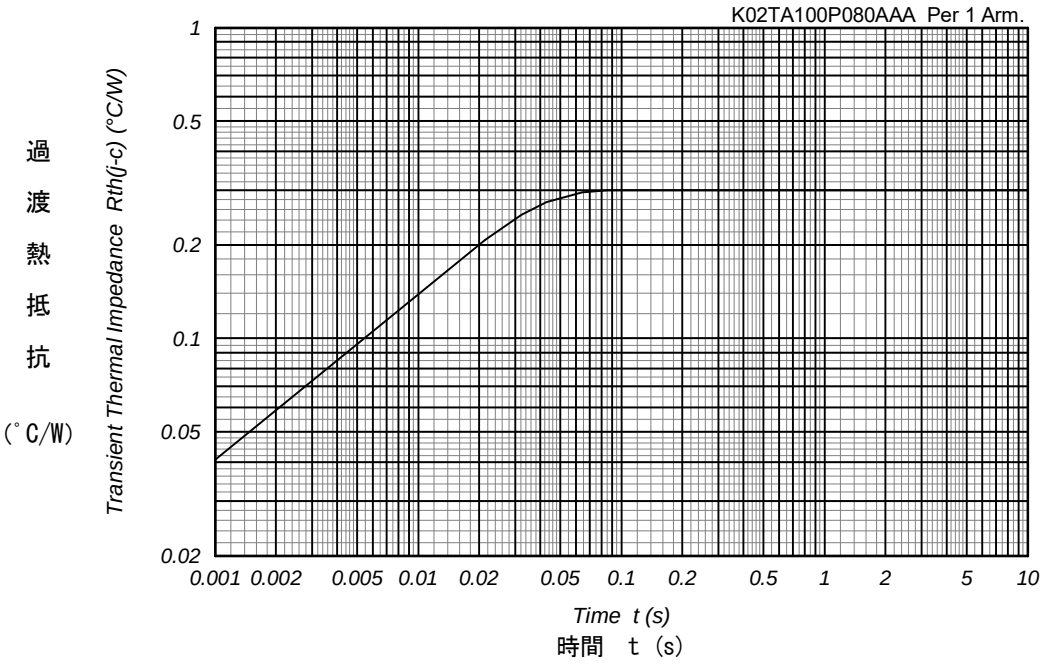


サ ー ジ オ ン 電 流 定 格
SURGE CURRENT RATINGS



サージオン電流（Ａ）

過 渡 熱 抵 抗 特 性
Transient Thermal Impedance



過渡熱抵抗（°C/W）